

KD1366

シリコンフォトダイオード



Silicon Photo Diode

Dimension(Unit:mm)



概要 Description

KD1366 は、プレーナータイプのシリコン・フォトダイオードチップを表面実装型パッケージに組み込んだフォトダイオードです。

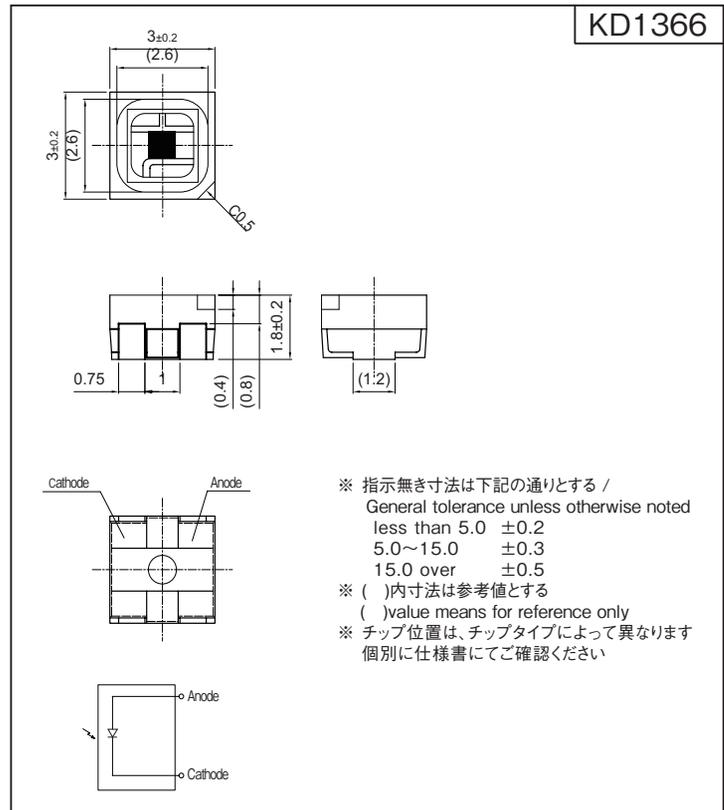
Model **KD1366** is silicon photodiode mounted in Surface mount package.

特長 Feature

- 高感度フォトダイオード (λ p:900nm)
- Photo diode (λ p:900nm)

用途 Application

- 紙幣のパターン読み取り用受光素子
- 紙幣パターン識別用受光素子
- Photo detector for Bill validator
- Photo detector for printing discrimination



最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Rating	Units
逆電圧 Reverse Voltage	VR	30	V
許容損失 Power Dissipation	PD	100	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +85	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30 ~ +95	°C
半田付温度 Soldering Temperature ※1	Tsol	260	°C

- ※ 1. 無鉛リフロー半田
※ 2. Ev : CIE 標準 A 光源
- ※ 1. Reflow process required
※ 2. Ev : CIE STD. A Light source

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Units
暗電流 Dark Current	ID	VR=10V, Ev=0 lux ※2	—	—	10	nA
短絡電流 Short Circuit Current	ISC	Ev=1000 lux ※2	0.5	—	—	μ A
ピーク感度波長 Peak Wavelength	λ p	—	—	900	—	nm
指向角半値幅 Half Angle	Δθ	—	—	± 60	—	deg
応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	VCC=5V, RL=1kΩ	—	3	—	μ sec
	下降 Fall Time		—	3	—	

** : Ta=25°C unless otherwise noted

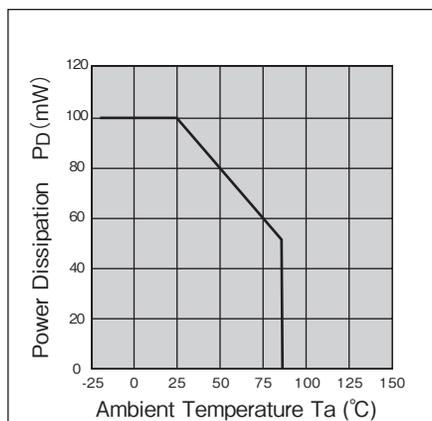
KD1366

定格・特性曲線 Characteristics

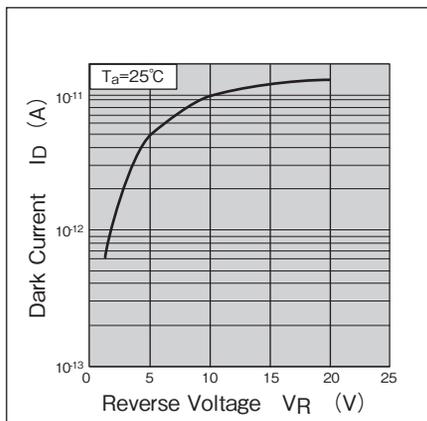
※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

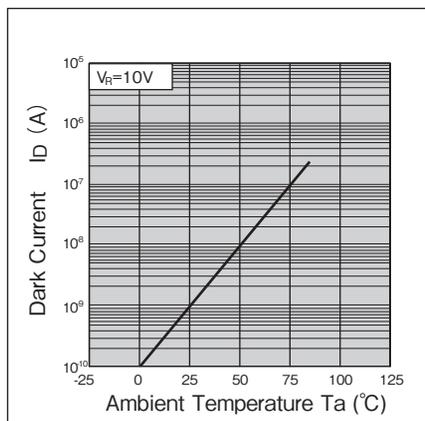
許容損失低減曲線



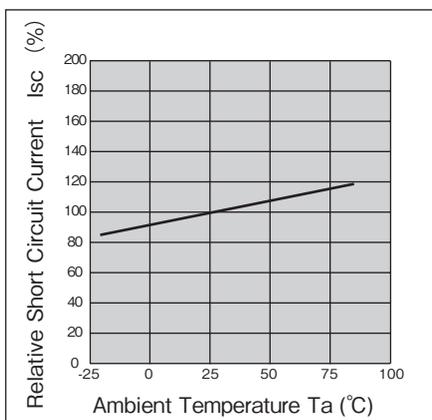
暗電流—逆電圧特性(代表例)



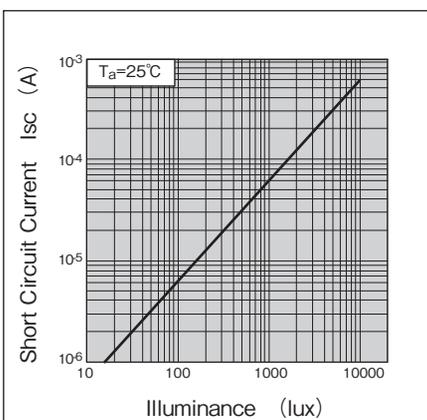
暗電流—周囲温度特性(代表例)



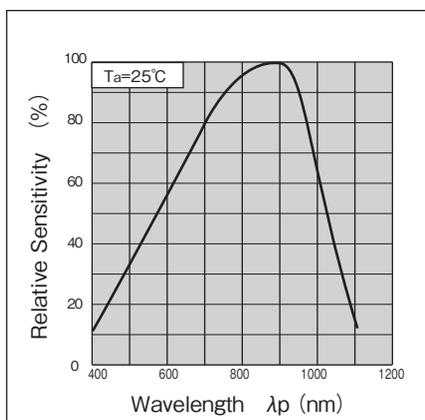
短絡電流—周囲温度特性(代表例)



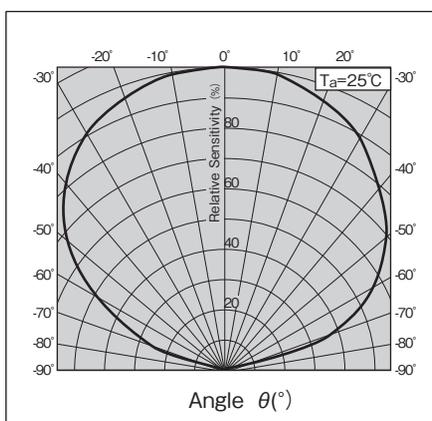
短絡電流—照度特性(代表例)



分光感度特性(代表例)



指向特性(代表例)



- ・ カスタムも承ります。お気軽にお問合せください。 ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・ A Custom designed package is available on request. ・ Specification are subject to change without notice.



□ Tokyo Office (International Sales Dept.): Zip:140-0013
8F, MARUITO OMORI 2nd bldg, 6-20-8,
Minami-oi, Shinagawa, Tokyo, JAPAN
Tel. +81 -3-6404-1003 / Fax. +81 -3-6404-1005

□ Head Office: Zip:250-0875
2-29-30, Minami-Kamonomiya, Odawara, Kanagawa, JAPAN
Tel. +81 -465-45-1212 / Fax. +81 -465-45-1213